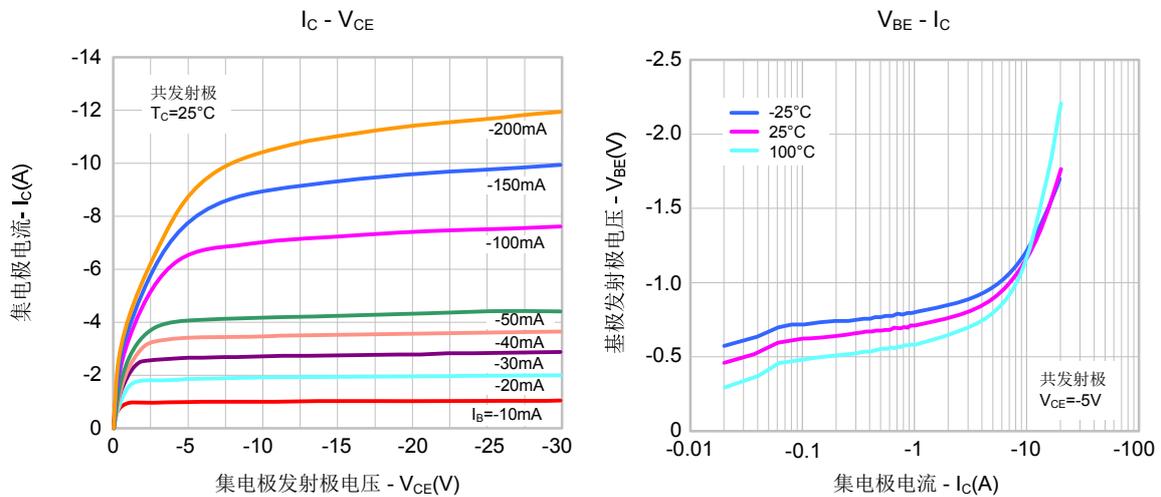


热阻特性

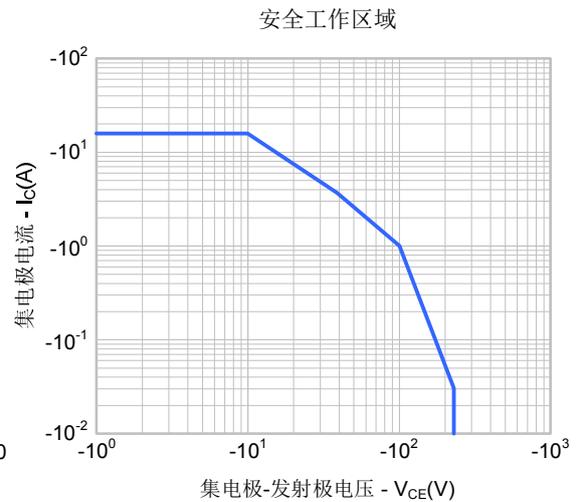
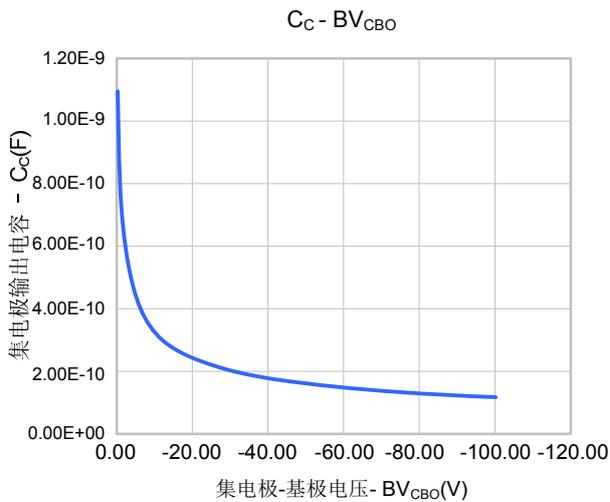
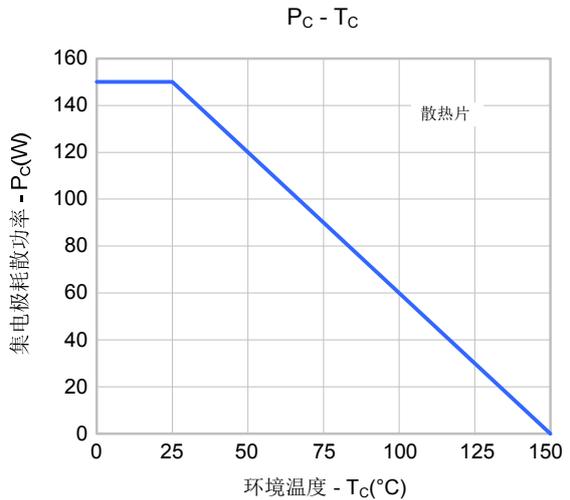
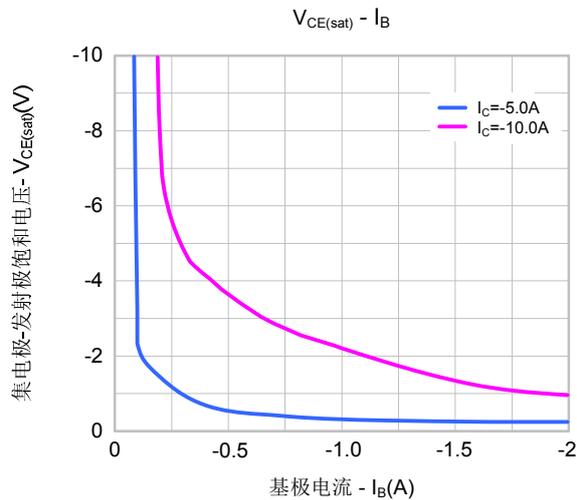
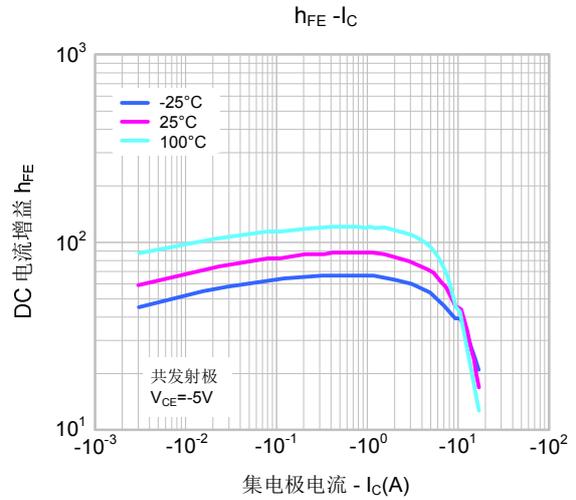
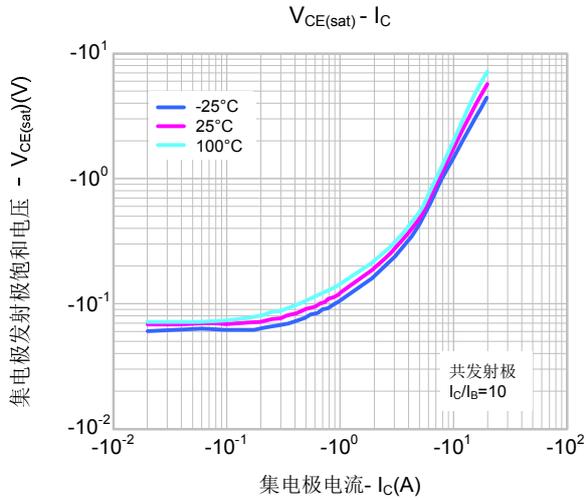
参 数	符 号	典型值	单 位
芯片对管壳热阻	R_{JC}	0.39	$^{\circ}C/W$

电参数(除非特殊说明, $T_a=25^{\circ}C$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型	最大值	单 位	
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-5V$, $I_C=-1A$	A	70	-	105	-
			B	95	-	130	-
			C	120	-	150	-
				$V_{CE}=-5V, I_C=-7A$	35	-	-
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-5A, I_B=-0.5A$	-	-1.2	-2	V	
基极、发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=-5V, I_C=-5A$	-	-1	-1.5	V	
集电极、基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CE}=-260V, I_B=0$	-	-	-5	μA	
集电极、发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-260V, I_B=0$	-	-	100	μA	
发射极、基极漏电流	I_{EBO}	$V_{CB}=-5V, I_C=0$	-	-	-5	μA	
三极管频率	FT	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	-	30	-	MHZ	
集电极输出电容	C_{OB}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	-	320	-	pF	

典型特性曲线


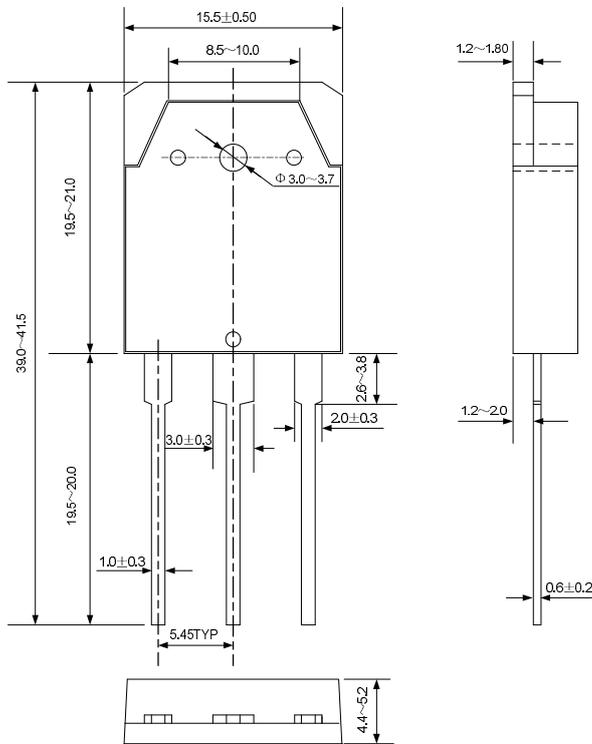
典型特性曲线



封装外形图

TO-3P

单位: mm



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SJT0302PPN	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	1.1	作 者:	殷资
------	-----	------	----

修改记录:

1. 增加热阻值
-

版 本:	1.0	作 者:	张科锋
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 修改典型特性曲线
-
-